

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

PATENT

#2
Priority
Paper
6/29/99
A Jenkins

In re application of: Naoya SASHIDA et al.

Serial No.: Not Yet Assigned

Filed: May 28, 1999

For: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

May 28, 1999

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application is hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

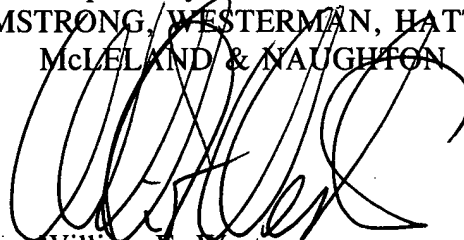
Japanese Appln. No.10-350892, filed December 10, 1998

In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicants have complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copy.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 01-2340.

Respectfully submitted,
ARMSTRONG, WESTERMAN, HATTORI
MCLELAND & NAUGHTON



William F. Westerman
Reg. No. 29,988

Atty. Docket No.: 990535
Suite 1000, 1725 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Tel: (202) 659-2930
Fax: (202) 887-0357
WFW/tmb

1649 U.S. 100
09/321603
05/28/99

整理番号 9801818

発送番号 108743

発送日 平成13年 5月15日 1 / 3

拒絶理由通知書

特許出願の番号	平成10年 特許願 第350892号
起案日	平成13年 4月10日
特許庁審査官	今井 拓也 9169 4M00
特許出願人代理人	岡本 啓三 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用例については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 9、10、1、2、7
- ・理由 1、2
- ・引用例 1
- ・備考

引用例1：特に【0016】－【0033】参照

続葉有

続 葉

・請求項 9、1、3、4、6、8

・理由 1、2

・引用例 2

・備考

引用例2：特に【0025】－【0047】参照

・請求項 1、3、8、9

・理由 1、2

・引用例 3

・備考

引用例3：特に【0028】－【0032】参照

・請求項 9、1

・理由 1、2

・引用例 4

・備考

特に第3頁左下欄第10行－第4頁左下欄第8行参照

・請求項 5

・理由 2

・引用例 2

・備考

キャパシタを覆う絶縁膜を、シランを用いて形成されたシリコン酸化膜とすることは周知の技術的事項であるから、引用例2に記載されている発明の第2又は第3絶縁膜に相当する絶縁膜をシランを用いて形成されたシリコン酸化膜をすることは当業者が容易に想到する事項である。

・請求項 10、2

・理由 2

・引用例 2

1

・備考

請求項10、2に記載されている発明と引用例2に記載されている発明とを対比すると、請求項10、2に記載されている発明では、局所配線に窒化金属を用

続葉有

続 葉

いている点で相違するものと認められる。

しかし、引用例1にも記載があるように、局所配線に用いる材料として窒化金属を用いることは周知であるから、上記相違点は単なる設計的事項であるものと認められる。

引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平10-223852号公報
2. 特開平09-097883号公報
3. 特開平07-111318号公報
4. 特開平04-102367号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版

H01L 21/8229
H01L 21/8242-8246
H01L 27/10-115

・先行技術文献

1. 特開平11-87633号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。